02

Зарядоперенос между нейтронно-индуцированным и активаторным центрами в монокристалле LuAG : Pr

© А.Х. Исламов¹, Э.М. Ибрагимова^{1,*}, И.А. Хайитов^{1,2}, Р.Р. Вильданов²

¹ Институт ядерной физики АН, Ташкент, 100214 Улугбек, Узбекистан ² Национальный университет Узбекистана, 100174 Ташкент, Узбекистан

e-mail: akhatqul@inp.uz; * e-mail: ibragimova@inp.uz

Поступила в редакцию 21.01.2021 г. В окончательной редакции 12.03.2021 г. Принята к публикации 08.04.2021 г.

Исследованы спектры поглощения, гамма-люминесценции и интегральные кривые термовысвечивания (300–605 К) номинально чистых кристаллов LuAG и активированных ионами празеодима (LuAG:Pr) до и после облучения быстрыми (> 0.1 MeV) нейтронами в интервале флюенсов $10^{15}-10^{17}$ cm⁻². Оптические спектры LuAG:Pr, облученного флюенсом 10^{17} cm⁻² нейтронов, после термического обесцвечивания до 605 К и последующего ⁶⁰Со γ -облучения и фотоподсветки в наведенной полосе 573 nm свидетельствуют о переносе электрона от наведенного $V_O(C_{dop})$ -центра к дырочному Pr^{4+} с излучением в Pr^{3+} . В случае облучения в суперколлайдере (HL-LHC) быстрыми нейтронами до $5 \cdot 10^{15}$ cm⁻² при > 300 K локализация электронов на наведенных дефектах F^+ и $V_O(C_{dop})$ и дырок на активаторных Pr^{4+} -центрах приводит к снижению интенсивности быстродействующего (20 ns) активаторного свечения и появлению длительной компоненты в отклике детектора.

Ключевые слова: лютеций алюминиевый гранат Lu₃Al₅O₁₂: Pr, нейтрон-наведенные дефекты, центры окраски, гамма-индуцированная люминесценция, термовысвечивание, люминесценция.

DOI: 10.21883/OS.2021.10.51489.1836-21

Введение

Сцинтилляционные материалы являются частью устройств, предназначенных для обнаружения высокоэнергетической радиации, гамма-квантов, ускоренных заряженных частиц и нейтронов [1,2]. Изучение физики новых частиц высоких энергий, например, на большом адронном коллайдере с высокой светимостью (HL-LHC), предполагает использование быстрых неорганических сцинтилляционных кристаллических детекторов, которые должны иметь высокую плотность, короткое время свечения, малую медленную составляющую и хорошую радиационную стойкость [3,4]. Ожидаемые в будущих экспериментах на HL-LHC светимость $5 \cdot 10^{34} \, \mathrm{cm}^{-2} \mathrm{s}^{-1}$ и интегральная светимость 3000 fb⁻¹, ионизационная доза до 130 Mrad, флюенсы заряженных адронов $3 \cdot 10^{14}$ cm⁻² и быстрых нейтронов $5 \cdot 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-2}$ [5].

Монокристаллы алюминий-лютециевого граната $Lu_3Al_5O_{12}$ (LuAG), активированного ионами празеодима Pr^{3+} (LuAG:Pr), рассматриваются В качестве сцинтилляторов [6,7] благодаря их высокой плотности $(6.7 \,\mathrm{g/cm^3})$, быстродействию ($\sim 20 \,\mathrm{ns}$), высокому световому выходу ($\sim 20\,000\, ph/MeV$), в три раза превышающему световыход Bi₄Ge₃O₁₂ (BGO) [8,9]. Однако для их практического использования необходимо было исследовать их радиационную оптическую стойкость к гамма-квантам и другим частицам высокой энергии. Показано, что деградация оптической прозрачности в ультрафиолетовой и видимой областях спектра номинально чистого LuAG и LuAG: Pr после облучения ионизирующими гамма-квантами (у) до 106 Gy обусловлена ростовыми дефектами [1,10,11]. В отличие от гамма-квантов ⁶⁰Со со средней энергией 1.25 MeV при воздействии флюенсами быстрых нейтронов 10^{16} и $10^{17} \, \mathrm{cm}^{-2}$ на номинально чистый LuAG генерировались структурные дефекты, существенно снижалась оптическая прозрачность в появившихся полосах поглощения 5.2 (238 nm), 4.8 (258 nm), 4.15 (298 nm), 3.3 (375 nm), 2.75 (450 nm) и 2.17 eV (570 nm). В то время как в легированном кристалле LuAG: Pr, кроме известных полос поглощения 5.15 (240 nm) и 4.34 eV (285 nm), приписываемых 4f - 5d-переходам в Pr^{3+} , также наблюдаются полосы 3.3 (375 nm), 2.75 (450 nm) и 2.17 eV (570 nm) как в нелегированном LuAG [12]. Кроме того, наблюдаемое уменьшение интенсивности полос фотолюминесценции при 310, 325 и 370 nm, связанных с переходами $5d \rightarrow 4f$ активаторов Pr^{3+} , предположительно связано с их реабсорбцией центрами окраски в областях 300-400 nm, индуцированными флюенсами быстрых нейтронов. Ионы Pr³⁺ могут захватывать дырки и переходить в Pr⁴⁺, а также стабилизировать захват кислородно-дефицитными электронов центрами, поглощающими на 378 и 570 nm; все это может привести к уменьшению излучательной рекомбинации.

Целью настоящей работы является изучение кинетики нейтронно-индуцированного накопления дефектов и механизмов их влияния на активаторные центры свечения в легированном LuAG: Pr. В отличие от нашей предыдущей работы [12] мы облучали в реакторе четырьмя флюенсами быстрых нейтронов в расширенных пределах $10^{15}-10^{17}$ сm⁻² с последующими измерениями спектров поглощения и рекомбинационной люминесценции в процессе гамма-облучения (гамма-люминесценция, ГЛ), а также при нагревании (термовысвечивание (ТВ) и термолюминесценция) и селективном фотообесцвечивании.

Объект и методы исследований

Монокристаллы номинально чистого LuAG и активированного празеодимом LuAG: Pr^{3+} (концентрация Pr 0.22 mol.%) были выращены методом Чохральского в атмосфере аргона (FurukawaCo. Ltd, Япония). Образцы для оптических исследований были приготовлены в виде пластин размером 4×4 mm и толщиной 1 mm с полированными поверхностями оптического качества.

Облучения смешанными нейтрон-гамма-потоками до флюенсов, ожидаемых в HL-LHC [5], проводили в реакторе BBP-CM в Институте ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУз, Ташкент). При мощности реактора 10 MWt общий нейтронный поток составлял $10^{14} \, \mathrm{cm}^{-2} \mathrm{s}^{-1}$ и сопровождался потоком у-квантов 37 Gy/s⋅cm² с энергиями 0.1-7 MeV. Поток быстрых нейтронов, попадающий на образцы, определялся по наведенной радиоактивности размещенного рядом Fe-Ni-монитора с пороговой энергией $E > 2.4 \, {\rm MeV}$ и составлял $3 \cdot 10^{13}$ cm⁻² · s⁻¹ [13]. Образцы с мониторами заворачивали в АІ-фольгу и помещали в Сd-стакан с толщиной стенок 1 mm, который пропускал только быстрые нейтроны с энергией > 0.1 MeV, которые могут смещать атомы кислорода и алюминия из узлов решетки. Стакан запаивали в кварцевую ампулу, которую помещали в стандартный АІ-контейнер, заполненный дистиллированной водой. Четыре контейнера с образцами облучали флюенсами быстрых нейтронов 10^{15} , 10^{16} , $5 \cdot 10^{16}$ и 10^{17} сm⁻². Распространенность в природе изотопов ¹⁷⁵Lu состаляет 97.4%, а ¹⁷⁶Lu — 2.6% [14]. При облучении на реакторе тепловыми нейтронами с энергей $E < 0.1 \, {\rm MeV}$ ¹⁷⁵Lu в результате реакцией (n, γ) преобразуется в метастабильный изотоп ^{176m}Lu с полураспадом 3.67 h, а 176 Lu \rightarrow ¹⁷⁷Lu с полураспадом 6.74 дня. При облучение быстрыми нейтронами с энергией $E > 0.1 \,\mathrm{MeV}^{-175} \mathrm{Lu}$ трансформируется в метастабильный изотоп ^{174m}Lu с полураспадом 157 дней с помощью реакции n2, n. Поэтому облученные в реакторе образцы стало возможным распаковывать только после 2 лет хранения и проводить измерения только в течение 1 h в день.

С целью перезарядки нейтронно-индуцированных центров после ТВ до 605 К было проведено гамма-облучение при температуре 310 К дозой 10^3 Gy от источника 60 Со со средней энергией γ -квантов 1.17 и 1.33 MeV и

мощностью 0.8 Gy/s в ИЯФ АН РУз. Для уменьшения потерь от темнового туннельного переноса зарядов между ловушками и обесцвечивания [11] время, прошедшее от завершения гамма-облучения до начала оптических измерений, не превышало 5 min.

Для переноса заряда между центрами путем селективного фотообесцвечивания нейтронно-облученных образцов использовали линии ртутной лампы (СВД-120А), выделенные монохроматором МДР-12.

Спектры оптического поглощения (ОП) до и после облучения измеряли при комнатной температуре 305 К на спектрофотометрах СФ-56 (ЛОМО) и LAMBDA-35 (PerkinElmer) в спектральной области 190–1100 nm.

Спектры ГЛ регистрировали при температуре 310 К с использованием дифракционного монохроматора МСД-1 с ФЭУ-39 в спектральной области 200–550 nm. Спектры ГЛ сканировали с максимально возможной скоростью развертки 20 nm/s с тем, чтобы накопленная доза не превышала 12 Gy.

Интегральные пики ТВ регистрировали с помощью ФЭУ-79 при постоянной скорости нагрева 0.25 К/s в интервале температур 300–605 К под контролем хромелькопелевой термопары. Спектры измеряли в диапазоне 250–450 nm (свечение Pr^{3+} и собственные дефекты в матрице) на МСД-1 со скоростью развертки 20 nm/s в непрерывном режиме. За время сканирования спектра (10 s) температура вырастала на 2.5 К, что меньше, чем полуширина пика ТВ.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1, *а* представлены спектральные зависимости коэффициента поглощения α (сm⁻¹) номинально чистого монокристалла LuAG до (кривая *I*) и после облучения флюенсом быстрых нейтронов 10¹⁷ cm⁻² (кривая *2*) [12], для которой проведено разложение на гауссианы, как показано на рис. 2. Различаются три полосы (G1–G3) с максимумами при 2.17 (570), 2.7 (458) и 3.2 eV (387 nm) и FWHM (полная ширина на полувысоте) 0.48, 0.75 и 0.80 eV соответственно. Полосы ОП 250, 295 и 390 nm совпадают с приведенными данными в [15–17] для YAG. Полоса 458 nm появляется также при ⁶⁰Со γ -облучении, поэтому отнесена к примесным центрам Cr⁴⁺ [11].

Поскольку полоса при 570 nm не появляется после γ -облучения дозой 5 · 10⁴ Gy в [1,10,11] и даже 10⁶ Gy [12], но наводится флюенсами больше 10¹⁶ cm⁻², она была приписана кислородной вакансии вблизи примеси, замещающей катион [12]. По аналогии с YAG нейтронно-индуцированные центры окраски в LuAG связаны с дефектами смещения в кислородной и алюминиевой подрешетках, которые образуют энергетические уровни в запрещенной зоне для локализации электронов и дырок, освобождение которых может привести к испусканию света, т.е. к термическому обесцвечиванию наведенных центров окраски.



Puc. 1. Спектры поглощения кристалла LuAG (*a*): необлученный (*I*), облучен флюенсом быстрых нейтронов 10^{17} cm⁻² (*2*), нагревание до 605 K при измерении TB (*3*), последующее облучение дозой 10^3 Gy (*4*). Кривые TB LuAG (*b*): после флюенса нейтронов 10^{17} cm⁻² (*I*), после γ-облучения дозой 10^3 Gy (*2*).

Для проверки термического освобождения ловушек в кристалле LuAG, облученном флюенсом быстрых нейтронов 10^{17} cm⁻², были измерены кривые TB в интервале температур от 300 до 605 К (рис. 1, *b*, кривая *1*). Здесь видны пики TB в области 445, 515 и 545 К. Для образца, облученного только ⁶⁰Со γ -квантами дозой 10^3 Gy пик 445 К не виден (рис. 1, *b*, кривая *2*), что подтверждается и в [11,18]. Это можно связать с созданием дополнительного локального уровня, ответственного за TB в области 445 К. Кроме того, интенсивности пиков TB 515 и 545 К в LuAG, облученном в реакторе,



Рис. 2. Спектр поглощения кристалла LuAG после флюенса нейтронов 10^{17} cm⁻² (сплошная кривая), его гауссовы составляющие (G1, G2, G3) и их сумма (пунктирная).

облучении только 60Со у-квантами. Причины этого связаны с приобретением сильной окраски (300-400 nm) образца LuAG после нейтрон-гамма-облучения в реакторе (рис. 1, а, кривая 2). После измерений ТВ в интервале температур 300-605 К в образце, облученном флюенсом нейтронов 10^{17} cm⁻², в спектре ОП наблюдается $\sim 50\%$ снижение максимумов полос ОП 250 (F), 295 (O⁻) и 390 (F⁺) nm, идентифицированных в [12], а полоса 570 nm практически не наблюдается (рис. 1, а, кривая 3). Это можно связать с термическим освобождением зарядов из ловушек и рекомбинацией их с носителями противоположного знака на других центрах, которые вызывают пики ТВ (рис. 1, *b*, кривая 1). При этом сами дефекты, генерированные нейтронами, на которых возможна локализация заряда, могут остаться. Тогда при последующем облучении этого образца ⁶⁰Со у-квантами должны заполняться носителями центры окраски, аналогичные наблюдаемым после облучения быстрыми нейтронами в сопровождении гамма-потока (рис. 1, а, кривая 2). Для этого облученный флюенсом нейтронов 10^{17} сm⁻² и нагретый до 605 К (при измерении ТВ) образец далее облучался ⁶⁰Со-у-квантами дозой 10^3 Gy. В результате в спектре ОП (рис. 1, *a*, кривая 4) наблюдались рост поглощения в полосах 250 и 298 nm, восстановление до предыдущего значения полос 387 и 458 nm и рост полосы 570 nm по (кривая 2).

приблизительно в 5 раз меньше, чем тех же пиков при

Так что эффект *γ*-облучения — зарядка как существующих ловушек (ростовые дефекты) [10,11], так и генерированных нейтронным облучением дефектов (кривая 4). В этом случае усиление полосы 570 nm, по-видимому,



Рис. 3. Спектры поглощения (*a*) и люминесценции, индуцированной ⁶⁰Со γ -источником (*b*) кристалла LuAG: Pr: исходный (*1*), после облучения флюенсами быстрых нейтронов 10^{15} (*2*), 10^{16} (*3*), $5 \cdot 10^{16}$ (*4*) и 10^{17} cm⁻² (5).

связано с тем, что при длительном хранении (в течение 6 лет) после облучения в реакторе связанные с этой полосой дефекты могли частично высвободить заряд (опустошались). Все это позволяет предположить, что дефект, ответственный за полосу 570 nm, связан с неконтролируемыми примесными катионами $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$, имеющими неглубокий уровень захвата (первыми освобождающими заряд).

Для определения вклада активаторного центра Pr^{3+} аналогичные исследования были проведены и с монокристаллами LuAG: Pr до и после облучения быстрыми нейтронами. Монокристалл LuAG: Pr является быстродействующим сцинтилляционным материалом с активаторным свечением Pr^{3+} в полосах 310, 325 и 375 nm, связанных с $d \rightarrow f$ -переходами [8,9,19].

В отличие от нашей предыдущей работы [12] проведены облучения четырьмя флюенсами быстрых нейтронов в интервале $10^{15}-10^{17}$ сm⁻², чтобы детально определить кинетику генерации дефектов и соответствующих изменений спектров поглощения и ГЛ. В результате будет определен флюенс нейтронов, при котором наведенные центры окраски снизят интенсивность активаторного свечения в ГЛ.

На рис. 3, *а* приведены спектры ОП образцов LuAG: Pr до и после облучения быстрыми нейтронами. В спектрах ОП исходного (кривая *I*) и облученного флюенсом нейтронов 10^{15} cm⁻² (кривая *2*) образцов наблюдаются известные полосы иона Pr³⁺ в области 240 и 285 nm $4f \rightarrow 5d$ -переходов и мультиплетные полосы 450–490 и 580–610 nm $4f \rightarrow 4f$ -переходов. С ростом флюенса нейтронов до 10^{16} (кривая *3*) и $5 \cdot 10^{16}$ cm⁻² (кривая *4*) коэффициент поглощения для полос 240 и 285 nm растет. Для этих полос при облучении флюенсом $\geq 5 \cdot 10^{16} \, \mathrm{cm}^{-2}$ (кривые 4 и 5) значение коэффициента поглощения $\alpha \approx 70-75 \, \mathrm{cm}^{-1}$ (при толщине образца 0.1 сm) достигает предела измерения прибора на пропускание.

Это увеличение, по-видимому, связано с сильным перекрытием с полосами 250 и 298 nm, наблюдаемыми в номинально чистых LuAG, интенсивность ОП которых с увеличением флюенса нейтронов также увеличивается [12].

В видимой области спектра интенсивность полосы ОП 387 nm (F^+), наблюдаемой при флюенсе нейтронов $\geq 10^{16}$ cm⁻², и широкой полосы 570 nm — при флюенсах $\geq 5 \cdot 10^{16}$ cm⁻² (рис. 3, *a*, кривые 3–5) растет, как и в чистом образце LuAG [12]. Спектр ОП LuAG: Pr после воздействия флюенсом быстрых нейтронов 10^{17} cm⁻² (рис. 3, *a*, кривая 5) был разложен на 3 гауссиана (G1–G3), как показано на рис. 4, и их спектры имеют максимумы при 2.16 (573), 2.7 (458) и 3.2 eV (387 nm) и FWHM (полная ширина на полувысоте) 0.49, 0.75 и 0.80 eV соответственно.

Сравнение спектров гауссова разложения на рис. 2 и 4 показывает их сходство и подтверждает принадлежность к собственным дефектам в подрешетках О и Al.

Интересно, что оба образца при флюенсе $5 \cdot 10^{16}$ сm⁻² окрашивались желто-коричневым цветом, который усиливался при 10^{17} cm⁻², как в кристалле YAG до $4.1 \cdot 10^{18}$ cm⁻² [16] и в YAG:Pr, дополнительно легированном ионами Mg²⁺ после термической обработки 1200°C в воздухе [20]. Окрашивание желто-коричневым цветом с характерным поглощением в интервале 300–600 nm связывается с зарядопереносным переходом Pr⁴⁺ (переход из кислородного лиганда к Pr⁴⁺) в матрице LuAG, дополнительно легированной



Рис. 4. Спектр поглощения кристалла LuAG: Pr после флюенса нейтронов 10^{17} cm⁻² (сплошная кривая), его гауссовы составляющие (G1, G2, G3) и их сумма (пунктир).

 Mg^{2+} и отожженной на воздухе: керамика в интервале 700–1500°С [21] и монокристалл при 1200°С [22]. По мнению авторов [22], термический отжиг в воздухе вызывает окисление Pr^{3+} до его Pr^{4+} -состояния (поглощение в области 300–600 nm), в то же время дополнительное легирование Mg^{2+} повышает его стабильность из-за компенсации заряда двухвалентного Mg^{2+} с помощью Pr^{4+} .

Из данных на рис. 1, *а* и 3, *а* можно заметить, что независимо от присутствия иона Pr^{3+} в кристалле LuAG нейтронное облучение флюенсом > 10^{16} cm⁻² вызывает желто-коричневое окрашивание и появление полос ОП 387 nm F^+ -центра и 573 nm, т.е. действительно они обусловлены структурными дефектами смещения в подрешетках кислорода и алюминия, как предполагалось выше. Из этого следует, что именно эти центры, наведенные нейтронами, захватывают электроны из зоны проводимости и стабилизируют Pr^{4+} -состояние. Но в таком случае уменьшится активаторное свечение при рекомбинации.

При возбуждении ⁶⁰Со γ -квантами исходного образца LuAG: Рг при 310 К в спектре ГЛ наблюдаются полосы свечения активатора Pr^{3+} 310, 325 и 375 nm (рис. 3, *b*, кривая *I*). Энергия рекомбинации генерированных электрон-дырочных пар соответствует межзонному переходу $E_g = 8.13 \text{ eV}$ (~ 152 nm) [23]. Свечение в LuAG: Рг, связанное с $5d \rightarrow 4f$ -переходами активатора ниже 4 eV, также возбуждается α -частицами ²⁴¹Am [24] и рентгеновским излучением [22,25].

При возбуждении ионизирующими 60 Со гамма-квантами ионы Pr^{3+} действуют как ловушки для дырок, захваченных из валентной зоны:

$$Pr^{3+} + h_v \to Pr^{4+}.$$
 (1)

Когда электрон захватывается из зоны проводимости и переходит из возбужденного состояния в основное 4f-состояние, ион $(\Pr^{3+})^*$ испускает квант:

$$\Pr^{4+} + e_{c^-} \to (\Pr^{3+})^* \to h\nu.$$
 (2)

Этот механизм эффективен, если не происходит прямая рекомбинация электронов и дырок или их захват другими дефектами. Обычно в монокристаллах YAG и LuAG полосы свечения 250 nm (экситона) и 335 nm (антиузельного центра Lu_{Al}, Al³⁺ в узле замещен изовалентным Lu³⁺, рекомбинация дырок с электроном, захваченным в Lu_{Al}), согласно [26,27], эффективно возбуждаются при 80 и 200 К соответственно.

Как видно из рис. 3, b, при флюенсах быстрых нейтронов $\geq 10^{15}$ cm⁻² интенсивности полос ГЛ 310, 325 и 375 nm при 310 K сильно уменьшаются (кривые 3-5). Возможно, это связано с тем, что увеличивающаяся концентрация наведенных дефектов конкурирует с центрами Pr^{3+} в процессе захвата носителей заряда и тем самым препятствует передаче энергии Pr^{3+} для возбуждения его люминесценции. Возможна также частичная реабсорбция люминесценции активатора Pr^{3+} нейтронноиндуцированными центрами окраски в спектральном диапазоне 300–400 nm (рис. 1, *a*, кривая 2 и рис. 3, *a*, кривые 3-5).

Для изучения влияния нейтронно-наведенных центров окраски в видимой области (полосы 390 и 570 nm) проведены последовательные измерения спектров ОП LuAG: Pr после облучения флюенсом нейтронов $10^{17} \, \text{cm}^{-2}$, а затем после нагрева до $605 \, \text{K}$ (после снятия ТВ) (рис. 5, *a*). При этом на интегральной кривой ТВ LuAG: Pr, облученного флюенсом нейтронов $10^{17} \,\mathrm{cm}^{-2}$ наблюдаются пики при 445, 515 и 545 К (рис. 5, b) (здесь усиление в 2 раза выше, чем в LuAG на рис. 1, b, кривая 1), которые совпадают с пиками ТВ номинально чистого LuAG (рис. 1, b). Экспериментальная кривая ТВ (рис. 5, b) анализировалась с использованием модели кинетики первого порядка в [28] и с помощью программного обеспечения GlowFit, которое подгоняет расчетную кривую, состоящую из пиков, используя метод наименьших квадратов Левенберга-Марквардта [29]. Рисунок 5, b показывает также результаты разложения экспериментальной кривой ТВ на компоненты, для которых определены интенсивности и положения пиков (T_m), которые составляют 444.2, 468.1, 520.1 и 545.5 К, и глубины ловушек (энергии активации E_t). Используя значения T_m и E_t в известном уравнении в [28], вычислены частотные факторы s (s⁻¹), приведенные в таблице.

После нагрева до 605 К при снятии ТВ облученного флюенсом нейтронов 10^{17} сm⁻² образца LuAG: Pr в его спектре ОП (рис. 5, *a*, кривая 3) наблюдалось следующее: интенсивности полос 240 и 285 nm не меняются, интенсивность полосы 390 nm F^+ -центра так же, как в чистом LuAG, снижается на ~ 50%, а полоса 573 nm $V_O(C_{прим})$ -центра практически исчезает. Наблюдаемое в



Puc. 5. Спектры поглощения кристаллов LuAG: Pr (*a*): исходный (*I*), последовательные воздействия флюенсом нейтронов 10^{17} cm⁻² (2), нагревом до 605 K при измерении TB (3), γ-облучения дозой 10^3 Gy (4). Кривые TB LuAG: Pr (*b*): исходный образец после флюенса нейтронов 10^{17} cm⁻² (сплошная кривая), его составляющие T₁, T₂, T₃ и T₄ и их сумма (пунктир).



Рис. 6. Спектры поглощения монокристалла LuAG: Pr (*a*): исходный (*I*), последовательные воздействия: флюенсом нейтронов 10^{17} cm⁻² и нагрев до 605 K при измерении TB (*2*), γ -облучение дозой 10^3 Gy (*3*), освещение светом с длиной волны 580 nm (*4*). Кривые TB монокристалла LuAG: Pr (*b*): облучение флюенсом нейтронов 10^{17} cm⁻², а затем ⁶⁰Co γ -облучение дозой 10^3 Gy (*I*), освещение светом с длиной волны 580 nm (*2*).

последних двух случаях можно охарактеризовать тем, что при энергиях активации 1.21, 1.41, 1.65 и 1.73 eV электроны, освобожденные из ловушек (центров окраски) рекомбинируют с дырочными Pr⁴⁺-центрами излучательно. Об этом свидетельствовал измеренный отдельно спектральный состав пиков TB 445 и 545 K, где наблюдались аналогичные со спектром ГЛ (рис. 3, *b*) полосы свечения 310 и 370 nm, связанные с 5d-4f-переходами возбужденного состояния (Pr^{3+})*. При последующем облучении образцов γ -квантами дозой 10³ Gy наблюдается уменьшение интенсивностей полос ОП 240 и 285 nm, связанных с Pr^{3+} (рис. 5, *a*, кривая 4), а также увеличение интенсивности полос 387, 458 и 573 nm по сравнению со случаем до нагрева (кривая 2). Это

1255

Положения максимума пиков $T_m,$ энергия активации E_t и частотные факторы s

Peak	T_m, \mathbf{K}	E_t , eV	s, s^{-1}
1	444.2	1.21	$\frac{1.56 \cdot 10^{11}}{4 \cdot 10^{11}}$
2	468.1	1.41	
3	520.1	1.65	$\begin{array}{c} 2.3 \cdot 10^{13} \\ 1.4 \cdot 10^{14} \end{array}$
4	545.5	1.73	

можно объяснить тем, что генерированные быстрыми нейтронами дефекты F^+ и $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$ при нагреве до 605 К сохраняются, так же как в номинально чистом LuAG. При последующем воздействии у-квантами образованные электроны захватываются на этих индуцированных дефектах, что приводит к росту полос ОП 387 nm F^+ -центра и 573 nm $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$ -центра (кривая 4). При этом часть дырок, согласно процессу (1), захватывается Pr^{3+} с образованием дырочного Pr^{4+} -центра, приводя к ослаблению полос 240 и 285 nm Pr³⁺-центра (кривая 4) и усилению полос 458 и 605 nm дырочных Cr⁴⁺-центров [11]. Следует отметить, что полосы ОП 387 и 573 nm при дополнительном *у*-облучении дозой 10³ Gy после высокотемпературного отжига при > 873 К на воздухе (при выдержке 30 min) облученных быстрыми нейтронами кристаллов LuAG и LuAG: Pr не появляются, в то время как остаются полосы 458 и 605 nm, относящиеся к центрам Cr^{4+} . Следовательно, при температуре ≥ 873 K междоузельный кислород диффундирует до анионной вакансии и залечивает ее.

Далее изучали оптическое обесцвечивание нейтроннонаведенных полос ОП для определения зарядового состояния центра (полоса 573 nm) как конкурента свечению Pr³⁺.

На рис. 6, а приведены спектры ОП исходного образца LuAG: Pr (кривая 1), после облучения флюенсом нейтронов $10^{17} \,\mathrm{cm}^{-2}$ и нагревания до 605 К (кривая 2), после последующего γ -облучения дозой 10³ Gy (кривая 3), далее после воздействия света на длине волны 580 nm (кривая 4). Видно, что после предыдущих процедур подсветки на длине волны 580 nm происходит рост интенсивности полос ОП 240 и 285 nm и снижение интенсивности полос 387 и 573 nm. За 60 min подсветки интенсивность полосы 387 nm снижается на 35%, а полосы 573 nm — на 60%. Можно добавить, что для LuAG и LuAG: Pr после подсветки на длине волны 400 nm (120 min) полосы ОП 387 и 573 nm ослаблялись на $\sim 10\%$. Подсветка на длине волны 250 nm кристалла LuAG, облученного флюенсом 10^{17} cm⁻², приводила к незначительному (3-5%) изменению поглощения на линии 250 nm, но это, по-видимому, было связано с недостаточной интенсивностью ультрафиолетового света. Наблюдаемые рост интенсивности полос ОП 240 и 285 nm (переход 4f - 5d Pr³⁺) и снижение интенсивности полос 387 nm F^+ -центра и 573 nm $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$ -центра при подсветке на линии 580 nm (рис. 6, *a*, кривая 4)

можно интерпретировать как освобождение электронов из ловушек (центров окраски) с рекомбинацией с Pr^{4+} -центрами и образованием Pr^{3+} . Фотообесцвечивание на длине волны 580 nm освобождает электроны только с ловушек. Тогда изменение концентрации этих наведенных центров окраски должно наблюдаться и в измерениях TB, результаты которых соответственно показали снижение интенсивности пика TB 444.2 K на ~ 50%, а интенсивности пиков 520.1 и 545.5 K на 22% (рис. 6, *b*, кривая 2) по сравнению с до подсвеченным состоянием (рис. 6, *b*, кривая *I*). Этот результат свидетельствует об участии кислородных вакансий около катионной, но не редкоземельной примеси $V_O(C_{dop})$, как ловушек электронов в рекомбинационном процессе TB с дырочным Pr^{4+} .

Заключение

Таким образом, вышеприведенные результаты по изучению оптических спектров LuAG: Pr облученного флюенсом нейтронов 10¹⁷ ст⁻², термического обесцвечивания до 605 К, последующего у-облучения и фотоподсветки в наведенной полосе 573 nm свидетельствуют о переносе электрона от наведенного $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$ -центра к дырочному Pr⁴⁺, который переходит в возбужденное состояние $(Pr^{3+})^*$, а потом в основное состояние с излучением. В случае высокодозного (для суперколлайдера) облучения нейтронами локализация электронов на наведенных дефектах F^+ и $V_{\rm O}(C_{\rm dop})$ и дырок на активаторных Pr⁴⁺-центрах приведет к снижению световыхода, связанного с активаторным свечением Pr³⁺, и появлению длительной компоненты в рекомбинационном процессе. В результате облучения быстрыми нейтронами до флюенса $10^{17} \,\mathrm{cm}^{-2}$ независимо от присутствия активатора Pr образуются центры окраски с полосами 390 nm (F^+ -центр) и 570 nm ($V_O(C_{dop})$ -центр), а также появляются пики ТВ при 444.1, 468.2, 520.1 и 545.5 К с энергиями активации 1.21, 1.41, 1.65 и 1.73 eV. После только у-облучения пик ТВ 444.1 К не наблюдается, что свидетельствует об образовании дополнительного локального уровня в запрещенной зоне при воздействии нейтронов.

Уменьшение интенсивности полос ГЛ активаторного Pr^{3+} -центра с ростом флюенса быстрых нейтронов $\geq 10^{15}~{\rm cm}^{-2}$ можно объяснить следующим образом:

— с одной стороны, возможна реабсорбция свечения Pr^{3+} в спектральной области 300–400 nm центрами окраски (дырочными O⁻ и электронными F⁺), концентрация которых растет с ростом флюенса нейтронов;

— с другой стороны, данные по дополнительному облучению γ -квантами после нагрева до 605 К нейтроннооблученного образца приводят к предположению о захвате дырки \Pr^{3+} - центром с образованием дырочного \Pr^{4+} -центра, вследствие чего снижается концентрация \Pr^{3+} -центров и увеличивается концентрация электронных F^+ - и $V_O(C_{dop})$ -центров. После фотоподсветки на длине волне 580 nm уменьшение интенсивности полосы ОП 573 nm, пика ТВ 444.1 К и увеличение интенсивности полос ОП 240 и 285 nm Pr^{3+} -центра можно трактовать как рекомбинацию части освобожденных из $V_O(C_{dop})$ -центра электронов с Pr^{4+} -центром с образованием Pr^{3+} . То есть нейтронно-индуцированный электронный центр, с одной стороны, становится конкурентом люминесцентному Pr^{3+} -центру в захвате электронов, а с другой стороны, приводит к стабильности Pr^{4+} -центра, отвечающего за медленный отклик сцинтиллятора.

Полученные результаты дают полезную информацию для определения радиационной стабильности окна оптической прозрачности и центров рекомбинационной люминесценции, так как ионизованные γ -облучением ростовые примесные и матричные дефекты, а также дефекты смещения кислорода быстрыми нейтронами обусловливают уменьшение светового выхода и увеличение амплитуды послесвечения [1,10–12].

Благодарности

Авторы благодарят А.Ф. Ракова и К. Камада за предоставленные образы и участие в обсуждении результатов работы.

финансирование работы

Работа выполнена в рамках бюджетной темы по Программе НИР ИЯФ АН РУз. Приложение 1 к Постановлению Президента РУз ПП-4526 от 21.11.2019.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Nikl M., Mihokova E., Laguta V., Pejchal J., Baccaro S., Vedda A. // Proc. SPIE. 2007. V. 6586. P. 6586OE-1–13.
- [2] Nikl M., Yoshikawa A. // Adv. Opt. Mater. 2015. V. 3. P. 1–19.
- [3] Zhu R.-Y., J. // China Univ. Metrol. 2014. V. 25. P. 107.
- [4] Auffray E., Fedorov A., Dormenev V., Houžvička J., Korjik M., Lucchini M.T., Mechinsky V., Ochesanu S. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. A. 2016. doi 10.1016/j.nima.2016.09.037
- [5] Bilki B. CMS Forward Calorimeters Phase II Upgrade // J. Physics: Conference Series. 2015. V. 587(1). P. 012014. doi 10.1088/1742-6596/587/1/012014
- [6] Lecoq P. // J. Physics: Conference Series. 2009. V. 160.
 P. 012016. doi 10.1088/1742-6596/160/1/012016
- [7] Pauwels K., Dujardin C., Gundacker S., Lebbou K., Lecoq P., Lucchini M., Moretti F., Petrosyan A.G., Xu X., Auffray E. // Published by IOP Publishing for Sissa Medialab. 2013. doi 10.1088/1748-0221/8/09/P09019
- [8] Nikl M., Ogino H., Krasnikov A., Beitlerova A., Yoshikawa A., Fukuda T. // Appl. Res. 2005. V. 202(1). P. R4.

- [9] Ogino H., Yoshikawa A., Nikl M., Kamada K., Fukuda T. // J. Cryst. Growth. 2006. V. 292. P. 239. doi 10.1016/j.jcrysgro.2006.04.021
- [10] Derdzyan M.V., Ovanesyan K.L., Petrosyan A.G., Belsky A., Dujardin C., Pedrini C., Auffray E., Lecoq P., Lucchini M., Pauwels K. // J. Cryst. Growth. 2012. V. 361. P. 212.
- [11] Исламов А.Х., Ибрагимова Э.М., Хайитов И.А., Вильданов Р.Р., Амонов М.З. // Опт. и спектр. 2018. Т. 125.
 № 1. С. 46; Islamov A.Kh., Ibragimova E.M., Khaiitov I.A., Vil'danov R.R., Amonov M.Z. // Opt. Spectrosc. 2018. V. 125.
 № 1. Р. 49. doi 10.1134/S0030400X18070147
- [12] Islamov A.Kh., Ibragimova E.M., Khayitov I.A., Vildanov R.R., Kudratov Kh.N. // Opt. Mater. 2019. V. 96. P. 109344. doi 10.1016/j.optmat.2019.109344
- [13] Islamov A.Kh., Salikhbaev U.S., Ibragimova E.M., Nuritdinov I., Fayzullaev B.S., Vukolov Yu.K., Orlovskiy I. // J. Nucl. Mater. 2013. V. 443. P. 393. doi 10.1016/j.jnucmat.2013.07.027
- [14] Меднис И.В. Справочные таблицы для нейтронноактивационного анализа. Рига: Зинатне, 1974. С. 412.
- [15] Вахидов Ш.А., Ибрагимова Э.М., Каипов Б., Тавшунский Г.А., Юсупов А.А. Радиационные явления в некоторых лазерных кристаллах. Ташкент: ФАН, 1977. С. 152.
- [16] Izerroukena M., Meftah A., Nekkab M. // J. Lumin. 2007. V. 127. P. 696.
- [17] Izerroukena M., Meftah A., Berkani S. // Nucl. Instru. and Meth. in Phys. Res. 2014. V. 326. P. 9. doi 10.1016/j.nimb.2013.08.069
- [18] Shen Y., Feng X., Shi Y., Vedda A., Moretti F., Hu Ch., Liu Sh., Pan Y., Kou H., Wu L. // Ceram. Int. 2014. V. 40. P. 3715.
- [19] Iwashita T., Miyabayashi K. // IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record. 2010. P. 278.
- [20] Pawlak D., Frukacz Z., Mierczyk Z., Suchocki A., Zachara J. // J. Alloys and Compounds. 1998. V. 275. P. 361.
- [21] Hu Z., Cao M., Chen H., Shi Y., Kou H., Xie T., Wu L., Pan Y., Feng X., Vedda A., Beitlerova A., Nikl M., Li J. // Opt. Mater. 2017. V. 72. P. 201.
- [22] Pejchal J., Buryi M., Babin V., Prusa P., Beitlerova A., Barta J., Havlak L., Kamada K., Yoshikawa A., Laguta V., Nikl M. // J. Lumin. 2017. V. 181. P. 277.
- [23] Zorenko Yu, Gorbenko V, Voloshinovskii A, Stryganyuk G, Mikhailin V, Kolobanov V, Spassky D, Nikl M, Blazek K. // Phys. Stat. Sol. (a). 2005. V. 202. N 6. P. 1113.
- [24] Yanagida T., Sato M., Kamada K., Fujimoto Y., Yokota Y., Yoshikawa A., Chani V. // Opt. Mater. 2011. V. 33. P. 413.
- [25] Ogino H., Yoshikawa A., Nikl M., Krasnikov A., Kamada K., Fukuda T. // J. Cryst. Growth. 2006. V. 287. P. 335.
- [26] Zorenko Yu., Voloshinovskii A., Savchyn V., Voznyak T., Nikl M., Nejezchleb K., Mikhailin V., Kolobanov V., Spassky D. // Phys. Stat. Sol. (b). 2007. V. 244. N 6. P. 2180.
- [27] Исламов А.Х., Нуритдинов И., Хайитов И.А., Хайитбоев И.А., Файзуллаев Б.С., Эсанов З.У., Эшбеков А.А. // Неорган. матер. 2016. Т. 52. № 5. С. 1; Islamov A.Kh., Nuritdinov I., Khayitov I.A., Khayitboev I.A., Fayzullaev B.S., Esanov Z.U., Eshbekov A.A. // Inorganic Mater. 2016. V. 52. N 5. P. 490. doi 10.1134/S002016851605006X
- [28] Kitis G., Gomez-Ros J.M., Tuyn J.W.N. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1998. V. 31. P. 2636.
- [29] Puchalska M., Bilski P. // Radiation Measurements. 2006. V. 41. P. 659.